最近の研究から

α-Sの S-K 端 XAFS の温度依存測定からわかった異常に強い S-S 結合

池本弘之¹, 宮永崇史² 1富山大学理学部物理学科,²弘前大学理工学部数物科学科

Extraordinary Rigid S-S Bond of α-S through Investigation via Temperature-Dependent Measurements of S-K Edge XAFS

Hiroyuki IKEMOTO¹, Takafumi MIYANAGA²

¹Department of Physics, University of Toyama, ²Department of Mathematics and Physics, Hirosaki University

Abstract

結晶安定相 α-S の基本構造である 8 員環の局所構造を調べるために, S-K 吸収端(2.472 keV)の透過 XAFS 測定を 10 ~ 300 K で行った。軟X線の吸収を抑え,さらに低温での測定を可能にするために,サンプルを真空中に置いて,透過 X線強度をフォトダイオードで検出した。8 員環を構成する共有結合の平均二乗相対変位を含めた全ての構造パラメーター は温度変化せず,3 次のキュミュラントは実質的にゼロであった。このことから,S-S 共有結合は非常に強く,かつその ポテンシャルの対称性が高いことが明らかになった。

1. はじめに

カルコゲン原子 (S, Se, Te) は 2 配位共有結合で 1 次構 造を構成し、さらにそれらが集積した2次構造をとる。こ の階層構造がカルコゲン群に独自の特徴をもたらす。常温 常圧では、Sは8員環を基本構造とした斜方晶系 S(a-S), SeとTeは3回らせん鎖を基本構造とした三方晶系Se,Te (t-Se, t-Te)が安定相である [1]。1 次構造のリング間ある いは鎖間の相互作用は、S, Se, Te と原子番号が大きくな るにつれて強くなる。したがって、カルコゲン元素を系統 的に調べることは、基本構造間の相互作用の役割が大きい カルコゲン群の物性に関する有益な情報を与える。t-Seと t-Teの構造の温度変化については、これまでに研究がなさ れている。X線回折(XRD)により, t-Se では温度上昇に 従って a 軸方向(らせん鎖間方向)には膨張する一方で c 軸方向(らせん軸方向)には収縮するが、ナノ結晶 Se で は粒径が小さくなると a, c 軸の両方ともが膨張することが 報告されている [2, 3]。t-Teの構造についても古くから研 究されてきたが、そのナノ粒子は近年新しい機能を有する 電子材料や光学材料として研究が進められており、さらに 1次元や2次元状態での構造や物性が XRD や透過型電子 顕微鏡などで研究されている [4]。これらに対し, α-Sの 構造の温度変化についての研究例はわずかである。最近, XRDと第一原理計算を用いて、 a-S の格子熱膨張と異方 性原子変位の温度依存性の研究が行われた。XRD の結果 は,格子定数および異方性原子変位が温度とともに大きく なるが、8員環内の S-S 結合距離は変化しないことを示し ている。これらは, 第一原理計算の結果と良い一致を示し ている [5]。

X線吸収微細構造(XAFS)解析は,XRDなどの回折手 法と並ぶ重要な構造解析の手法である。XRD と比較する と, XAFS 法は局所構造探索に強く [6], 選択した元素周 辺で個別の元素との原子相関を明らかにできるアドバンテ ージがある。さらに広域 XAFS(EXAFS)解析から得られる, 原子間距離の平均二乗相対変位(MSRD)の温度依存性を 解析することにより、選択した元素間の原子相関の強さを 求めることができる [6]。これらのことは、強い1次原子 相関と弱い2次原子相関が共存するというユニークな階層 性を持つカルコゲンの構造研究において、それぞれの原子 相関, さらには1次構造と2次構造の関係を検討するのに 有用である。これまでのカルコゲン元素に関する EXAFS 解析により, t-Se では温度の上昇に伴って共有結合長が短 くなることや[7], 融解時に Seや Teの共有結合長が短く なることなど、多くの物質とは異なる構造変化が明らかに なっている [8]。また、モルデナイトやカーボンナノチュ ーブに包摂された Se 孤立鎖や Te 孤立鎖では、鎖間相互作 用の消失により、共有結合長が短くなり、その結合力が増 加することがわかった [7,9,10]。さらに, MSRD の温度解 析から Se の共有結合の強さが Te よりも強いことも確認さ れた。

このように、カルコゲンの中でも Se や Te については 理解が進んできているが、S についての温度変化に関す る研究例は少ない。a-S の XRD の温度変化に関しては報 告されているが、XAFS 解析のアドバンテージを生かし た温度変化に関する研究は、XRD とは異なる情報を与え ることが期待される。例えば、EXAFS 解析により得られ る MSRD の温度解析から、a-S の基本構造である 8 員環 の共有結合の強さを評価できる。しかしながら、これま では低温領域を含む温度変化の測定が行われてこなかっ た。低温での S-K 端の XAFS 測定が難しいのは, S-K 端 (2.472 keV)のエネルギーが放射光においてもテンダー領 域と呼ばれようにX線強度が弱く、さらに低エネルギーで あるがゆえに空気をはじめとした物質によるX線の吸収を 無視できないからである。したがって、低エネルギーのX 線の吸収を極力排除するために, He ガスや真空中などの 特殊な環境下で S-K 端の XAFS 測定は行われる。これま でのところ、現実的な測定法として、He ガスを試料の周 りに流す転換電子収量(CEY)法[11, 12],あるいは試料 を真空中に設置する電子収量法や、蛍光収量法がよく用い られてきた。特に CEY 法は、S を含む材料に対して優れ た結果をもたらし, S 混合化合物の重要性から材料科学と 産業に貢献している [13]。しかし、試料の周りに He ガス を流す CEY 法では低温の XAFS 測定は無理である。通常 よく用いられる電流検出による電子収量測定では低温測定 が可能であるが、EXAFS 領域でシグナルのバックグラン ドが差し引きにくいなど、詳細な構造解析に必要な高波数 領域にわたっての良質なX線吸収スペクトルを得ることが 難しい。これらの電子収量法ではなく蛍光法が用いられる 場合もあるが、S 原子の自己吸収効果を防ぐためにサブミ クロンオーダーの非常に薄い試料が必要であり、サンプル 調製が困難である。

このような状況のもと、最近我々は透過法により低温か ら室温までの S-K 吸収端の XAFS 測定を行って、a-S の共 有結合の強さに関する興味深い結果を得た [14]。この際に、 我々は良質な XAFS データを得るための原点にたち帰っ て透過法による S-K 端の XAFS 測定の可能性を、さらに 低温で測定するために真空中での測定を検討した。a-S を 真空中に置いた場合に想定される X線光路上の、a-S、基 板のカーボン、窓材のカプトン膜などの X線透過率を計算 した結果、透過法測定が可能であると判断した。さらに X 線吸収を抑えるために窓材がないフォトダイオード (PD) を用いて、透過 X線強度を検出した。これらの工夫によ り、低温から室温にわたる温度領域で XAFS 測定に成功し、 a-S の構造パラメータの温度依存性を初めて求めることが できた [14]。本レポートでは、この研究について、特に測 定手法を詳細に紹介し, α-S 中の S-S 共有結合の特徴を明 らかにしたうえで,同族の t-Se 及び t-Te と比較して議論 する。

2. 実験と解析方法

透過 XAFS 測定において S 試料の最適厚はエッジジャ ンプが1になる約3 μm であるが,バルクSからこのよう に薄くて一様なサンプルを切り出すのは困難である。そ こで、真空中 (3.0 × 10⁻⁶ Torr) で多層カーボンナノチュー ブシート (MWCNT, 厚さ 0.6~4 µm の範囲) 上に硫黄 (純 度 99.999%, NewMet)を薄く堆積させた薄膜を試料とした。 吸収端のエッジジャンプから得た測定に用いたSサンプ ル厚は 3.4 µm である。MWCNT を薄膜基板として選んだ のは、測定エネルギー領域でのX線透過率が高く、また自 立膜として容易に入手できるからである。蒸気圧の高い硫 黄が真空中で蒸発するのを防ぐために、試料をカプトンフ ィルム(厚さ7.5 µm)で覆った。しかしながら、この薄 膜が α-S である保証はない。結晶系の同定は XRD で行う のが基本であるが、 試料厚が薄いためにブラッグピークを 観測できなかった。そこで、次善の策として Raman 測定(日 本分光 NRS7100, 励起光 532 nm) を行い, a-, β-, γ-S の Raman スペクトルと比較した [15]。それぞれの結晶系の 特徴的なピークと比較した結果、我々が作製したS薄膜 は α-S であると判断した。PD を用いた透過法で適切なデ ータが得られているかを検証するために, S-K 吸収端測定 での標準的な手法である CEY 測定を室温で行った。CEY 法の試料は硫黄粉末(純度 98%, 和光純薬工業株式会社) を用いた。

S-K 端のX線吸収スペクトルの測定は,KEK-PF BL-9A ビームラインの軟X線測定モードで行った。軟X線測定 モードの標準セットアップでは,I。測定用イオンチャンバ ー,サンプルホルダー,CEY検出器,Lytle検出器が一体 化されており,その中をHeを流すことにより,X線の吸 収を極力抑えている。我々が使用した透過測定用のサン プルチャンバーの概略図 (a)およびそれらの写真(b~d) を Fig.1に示す。He ガスフロー部と真空部はX線入射窓 で区切られ,上流側には I。検出用の PF のイオンチャンバ ー,下流側にはサンプルと PD 検出器を内包した真空チャ



Figure 1 (a) Sample chamber designed for XAFS measurements with transmission mode. The green section indicates the sample containing the thin S-film, MWCNT, and Kapton film, which are attached to the sample holder connected to the cryocooler. Photo Diode (PD) is indicated with red, which directly detects the transmitted x-ray in a vacuum. The Kapton window is indicated in blue. (b) Photo of PD (c) Photo of sample holder attached on cold head. (d) Photo of sample chamber.

ンバーとなっている。カプトン窓の上流側では He ガス中 を、下流側では真空中を、X線を透過させて空気による吸 収をなくした。真空チャンバーのX線入射窓には入手可能 な最薄の 7.5 µm のカプトンフィルムを用いた。透過X線 強度の検出には窓材がなく検出器が剥き出しになった Si p-intrinsic-n Photodiode(PD) (HAMAMATSU S14605)を用い、 基本的な回路でX線強度を電流に変換して PF 備え付けの アンプでモニターした。Fig. 1(b) はサンプルチャンバーに 取り付ける前の PD, (c) はクライオホルダーに取り付けら れた試料, (d) はサンプルチャンバーの全貌の写真である。 試料は 10 ~ 300K の温度範囲で測定した。

Fig. 2 は, I₀ 測定用イオンチャンバーから PD 検出器 までの光路上にある,Sサンプル(膜厚 3.4 µm),X線 窓と試料カバーの2枚のカプトン膜,および蒸着基板の MWCNT のそれぞれと全てのX線透過率の計算値を示す [16]。X線吸収をできるだけ抑制した工夫により,測定X 線エネルギー範囲全体で総透過率が15%を超え,このセ ットアップで透過モードでのS-Kエッジの XAFS 測定が 可能であることが確認できる。

EXAFS 解析の全工程を miXAFS プログラム [17] により 解析した。 $\chi(k)$ 関数の導出には、AUTOBK 法 [18] を用い て R_{bkg} を1Åとした。共有結合に由来する EXAFS 信号を 抽出するために、EXAFS 信号を 4.0–13.5Å⁻¹の範囲でハミ ングウィンドウを使用してフーリエ変換し、さらに共有結 合に対応する最初のピークを 1.35Å–2.70Åの範囲で逆フ ーリエ変換した。この EXAFS 信号に k^2 の重みをつけた関 数に対して、1サイトの非線形最小二乗法解析を行った。 その際に、下記の EXAFS 基本公式を用いた。



Figure 2 The theoretical transmittance for S of $3.4 \,\mu\text{m}$ thickness (green dotted line), Kapton of 15 μ m thickness (brown broken line), carbon of 2 μ m thickness (black thin solid line), and the total (red thick solid line).

ここで,Pは規格化係数, r_j はj番目の原子距離, N_j は配位数, C_{3j} は3次キュムラント, σ_j^2 はMSRD, ΔE_0 は吸収端から のエネルギーシフトである。 r_j , N_j , C_{3j} , σ_j を自由パラメ ータとし,位相シフト(ϕ_j),平均自由行程(λ_j),および後 方散乱振幅(f_j)は,FEFF8.4 プログラムの計算値を用いた [19]。

3. 実験結果

3-1. 硫黄の低温測定

我々は、S-K 吸収端の XAFS 測定として広く行われて いる CEY 法ではなく透過法を用い, さらに透過 X 線強度 を PD によって検出した。そこで、我々が透過法で得た XAFS 信号が適切であることを示すために、透過法と CEY 法の室温におけるシグナルを Fig.3 で比較した。XAFS ス ペクトル,特に XANES 領域を比較する際には,解析プロ グラム ATHENA の規格化スペクトルがよく用いられてい る [20]。これは便利な機能ではあるが、ATHENA で得ら れる XAFS スペクトルは、バックグラウンドスペクトル の取り方に強く依存するので注意が必要である。特に第1 ピーク付近のバックグラウンドを得るのが困難で、不自然 なバックグラウンドによってスペクトルが大きく歪んでし まうことがある。そこで、我々は XAFS スペクトル導出 の原点に立ち帰り、実験から得られた µt から S-K 吸収端 前の吸収曲線を単純に引いて、さらにエッジジャンプで規 格化して比較した。この際に吸収端前の吸収曲線を外挿す るので、より自然な吸収曲線を得るためにX線吸収端前後 の Victoreen 係数を活用する XANADU 手法を用いた [21]。 Fig. 3 に示すように、多少の違いはあるが両者のスペクト ルはほぼ一致していることから、我々が用いた透過法で信 頼できるデータが得られていることが確認できた。実行前 には、PDを用いた透過法で十分なダイナミックレンジが 確保できるかも危惧したが、エッジジャンプの3倍強もあ る第1ピークも再現しており、PDが十分なダイナミック レンジを有していることが確認できた。

このように、PDを用いた透過 XAFS 測定は、空気によ



Figure 3 Comparison of the XANES spectra of α-S between CEY (black dashed line) and transmission mode (red solid line) measurements at 300 K.



Figure 4 Ar-K edge XAFS appeared around 3.2 keV.

る吸収が大きく影響する軟X線領域でのXAFS測定で有効である。ただし、イオンチャンバーと比較するとPDのオフセットの値が大きいことは残された課題である。一方、本研究とは直接関係しないが、Sn-K吸収端(29.200 keV)のXAFS測定でもPDが有効であることを検証しており、高エネルギー領域でのI₁検出ガスのKrが入手困難な中、PDの活用が期待される。

波数 20Å⁻¹までの XAFS スペクトルを得るために, 2.2 ~ 4.0 keV のエネルギー範囲で XAFS 測定を行った。 しかしながら,わずかであるが Ar-K 吸収端の XAFS スペ クトルが,透過法でも CEY 法でも観測された。Fig. 4 は Ar-K 吸収端近傍の測定を拡大したものであるが,そのエ ネルギーと形状が文献 [22] と同一であった。当初は,S 試 料設置時に混入した大気中の Ar ガスを検出していると推 測したが,ビームタイムがマシンスタディをまたがった際 に He ガスを 24 時間以上フローさせ続けて徹底して空気 から He への置換を行ったが,Ar ガスのシグナルは消失し なかった。したがって,He ガス中に混入している Ar の影 響であると考えている。さらに,高純度の G1 グレードの He ガスを試したが Ar の影響を排除することはできなかっ た。

Fig. 5 に得られた EXAFS 関数を示すが,最低温の 10K から室温付近の 300 K にわたる温度領域で,13.5Å⁻¹ までの波数域で十分な振動が観測された。興味深いことに,その振幅は温度によらずほぼ同じであり,特に MSRD の影響が出やすい高波数領域でも温度上昇による減衰が見られない。このことは,MSRD が測定温度領域では温度に依存しないこと,さらには強い共有結合を示唆する。

大まかな原子相関を見るために, kχ(k)のフーリエ変換 [FT(r)]を Fig. 6 に示す。フーリエ変換の際に位相因子の補 正を行っているので,原子間距離は実際の値に近い。*a*-S では、2Å付近の第1ピークの領域には共有結合による原 子相関のみが存在する。一方,第2ピークの2.7~4.0Å の領域には、8員環内部の2種類の第2近接原子相関,さ らに隣接する8員環間の第1近接などが混在している。 χ(k)の温度変化から推測できるように,第1ピークの高さ は温度によらずほぼ一定である。これに対し,第2ピーク



Figure 5 Variation of the $k^2 \chi(k)$ of α -S at10K (red solid line) and 300 K (black dashed line).



Figure 6 |FT(r)| of α-S at 10 K (red solid line) and 300 K (black dashed line).

は温度上昇によりピークの高さは減少しているが半減程度 である。さらに、8員環同士の相互作用が非常に弱いこと を考えると、この第2ピークには8員環内部の第2近接の 寄与が主要であると推測している。第1ピークと第2ピー クの温度変化を明確に比較するために、Fig.7に最低温の [FT(r)]のピーク高さで規格化したピークの高さの温度変化 をプロットしている。この図から、第1ピークの高さが温 度によらず一定であり、第2ピークが温度上昇とともに線 形に減少していることが分かる。第1、第2ピークの高さ の温度変化から、共有結合は非常に強いが、Sの8員環の 結合角はそれに比べると弱く(柔らかく)、温度の変化を 受けやすいことが分かる。これ以降は、共有結合のみを含 む第1ピークに焦点を絞り、8員環内の共有結合について 議論する。

α-Sの共有結合の構造パラメーターを得るために, Fig.6 の第1ピークだけを逆フーリエ変換し,1サイトによる非 線形最小二乗法フィッティングを行った。構造パラメータ ーのうち一般的には温度変化の大きい MSRD を除く,原 子間距離 r,配位数 N,3次のキュミュラント C₃の全温度 領域の平均値を Table 1 に示す。EXAFS 解析による原子間 距離の精度が約 0.02Å であることを考えると,得られた共



Figure 7 Temperature variation of the first peak height (red circles) and second one (black crosses) of |FT(r)| of α -S.

Table 1Structure parameters of r, N and C_3 obtained from the EXAFSanalysis for S-S covalent bond in α -S.



Figure 8 The temperature variation of the MSRD for the covalent bond of α -S, which was obtained from the S K-edge XAFS measurements. The solid lines show the Einstein model fitting.

有結合長は XRD 実験から得られている 2.055Å[23] と一致 している。さらに,共有結合長の温度分散は,EXAFS か ら得られる原子間距離の精度以下であるので,300 K 以下 では共有結合長が変化しないと言える。このことは,Fig. 6 の |FT(r)| のピーク位置の違いが 0.002Å 以下であること からも裏付けられる。このように共有結合長が温度変化し ないことは、8 員環内の共有結合が熱擾乱を受けない非常 に強い共有結合であることを示唆する。共有結合の強さを 色濃く反映する MSRD を Fig. 8 に示す。a-S の MSRD に 温度変化はほとんど見られず, $\chi(k)$ がほとんど温度変化し ないことに対応している。MSRD が温度変化しないことは、 高温側で MSRD が明らかに増加する同族の t-Se や t-Te, さらには多くの物質と比べると対照的である。このことは、 共有結合長の温度変化と同様に共有結合が非常に強いこと を示唆する。一方,非対称パラメーター C_3 の温度平均は, -1.4±2.5 × 10⁻⁵Å⁻³ であり,実質的に0と見なせる。このこ とは,共有結合のポテンシャルが対称的であることを示唆 する。これらは XRD の結果と対照的である。XRD の解析 結果およびその第一原理計算でも S-S 共有結合の距離は温 度に対してほとんど変化していないが,それらの異方性原 子変位を示す楕円体は温度が上昇するにつれて大きくなっ ているのに対して [5], EXAFS から求めた MSRD は温度 に対して一定である。これは,EXAFS の情報が S-S 共有 結合距離の相対的な変位を反映していることに起因してい る。

3-2. 他のカルコゲンと比較した議論

以上のように、α-Sの共有結合の全ての構造パラメータ ーは温度変化しない。このように温度に対して不変である ことは,他の物質と比較すると異常である。特に, MSRD の異常に小さな温度変化は特筆すべきである。MSRD の 起源は熱擾乱によってもたらされる原子間距離の相対変化 であり,この温度変化を解析することにより原子間相互 作用の強さについて具体的に考えることができる。MSRD の温度依存性の解析方法としては、アインシュタインモデ ルとデバイモデルが代表的である。アインシュタインモデ ルは孤立した分子の解析に適し, デバイモデルはフォノン の分散がある系に適している。α-Sでは基本構造の8員環 は半ば孤立していて分子的であるので、われわれはアイン シュタインモデルで解析を行った。得られたアインシュタ イン温度を Table 2 に示す。アインシュタインモデルでの 解析では、アインシュタイン温度は MSRD の温度変化の 傾斜に強く依存する。Fig. 8にあるように、α-Sではほと んど温度変化しておらず、室温付近でようやく微小な増加 が見られるのみである。さらに分散が大きいこともあり, 得られたアインシュタイン温度は非常に大きな誤差を含む ものとなった。

アインシュタイン温度は物質固有の値であるが,他のカ ルコゲン元素と比較するためには力定数の方が適切であ る。同じ量で比較するために,t-Seとt-Teもアインシュタ インモデルで解析した。α-S,t-Se,t-Teのアインシュタイ ン温度,さらにアインシュタイン温度から求めた力定数 を,Table 2 で比較している。α-Sの力定数は文献によると 237 Nm⁻¹ [24] であり,得られた力定数とは異なっているが, 誤差の範囲内には収まっている。α-Sの力定数はカルコゲ ン元素の安定相の中では最も大きく,t-Seの3.4倍,t-Te の4.9倍である。

α-S での共有結合の構造パラメーターが温度に依存しな

 Table 2
 Comparison of the 1NN distances (r_{XRD}) and (r_{CB}) in Å, θ_E (K), and K (N m⁻¹) for α -S, t-Se, and t-Te.

| Element | $r_{\rm XRD}$ (Å) | $r_{\rm CB}({ m \AA})$ | $\theta_{E}(K)$ | K (N m ⁻¹) |
|---------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| a-S | 2.055 [23] | 2.054 | 942±323 | 405±284 |
| t-Se | 2.375 [26] | 2.37 [7] | 325±6 [7] | 119±4 [7] |
| t-Te | 2.865 [27] | 2.84 [28] | 212±3 [7] | 82±3 [7] |

い異常さは、カルコゲン元素特有の階層性と、カルコゲン 元素内でSが原子番号が最も小さいことが深く関係して いる。カルコゲン原子は、共有結合でできた8員環あるい は3回らせん鎖が基本構造であり、基本構造間の相互作用 によって互いに結びつく階層性が特徴である。この基本構 造間の相互作用は、鎖内共有結合と鎖間第1近接の距離の 比などに見られるように、原子番号が大きくなるにつれて 強くなる。基本構造間の相互作用が共有結合に与える影響 が明確に現れるのは、基本構造間の相互作用が消失する融 解時である。SeとTeでは、融解時に共有結合が短くなる 異常が生じるが、これは共有結合を弱める鎖間相互作用が 消失するためである。

残念ながら,Sの場合は,液体容器のX線吸収が非常に 大きいので融解時の挙動についてXAFS実験することは, 今回の手法でも難しい。液体Sの共有結合は中性子回折 実験から2.06±0.01Åと報告されており[25],α-Sの2.055 Åと比較すると共有結合が融解時に変化しないことが分か る。t-Seとt-Teでは孤立電子対と隣接鎖上の反結合軌道の 重なりが共有結合に影響を及ぼすのに対し,半ば孤立した 8員環がスタックしたα-Sではこのような重なりがないこ とがS-Sの強い共有結合をもたらしていると考えている。 共有結合に対する環/鎖間相互作用の影響を調べる他のア プローチは,カーボンナノチューブなどの狭い空洞中にS 分子を包摂して,相互作用のない状態での構造を調べるこ とであり,我々は現在その研究を進めている。

4. まとめ

本研究では、透過X線強度の検出にフォトダイオード を用いた透過法により、10 K から 300 K の温度範囲で α-S に対して S-K 端の XAFS 測定を行った。これにより、 a-S の構造パラメータ(原子間距離, MSRD および C₃)の温 度変化を初めて得ることができた。EXAFS 関数 kx(k) のフ ーリエ変換 |FT(r)| では、温度が 10 K から 300 K に上昇し た際に,熱擾乱にもかかわらず,8員環の共有結合に対応 する最初のピークの高さの減少はわずかであった。一方, リング内およびリング間の相関がいくつか含まれる2番目 のピークは10Kから300Kに上昇するに従って,通常の 物質と同様にピーク強度は減少した。EXAFS 信号に対す る非線形最小二乗フィッティングによって得られた α-S の S-S 共有結合の構造パラメータは、温度変化に対してほぼ 一定であった。温度に最も敏感な MSRD も温度に対して 一定であることから、共有結合のポテンシャル障壁が極め て高いことがわかる。この結果は、異方性原子変位が温度 上昇に対して増加している XRD や第一原理計算の結果と は対照的である。また、C,の値が実質的にゼロで温度に 対して変化しないことから, 共有結合の結合ポテンシャル の形状が対称的であることがわかる。MSRD の温度変化 をアインシュタインモデルで解析して、アインシュタイン 温度 942 K, 力定数 (K) 405 N m⁻¹ を得た。他のカルコゲン 元素 (t-Se, t-Te) と比べると, この α-S の K の値は非常に 大きい値である。

謝辞

本研究は Md Saiful Islam 氏および河口玲央氏との共同 研究である。この場を借りてお礼申し上げる。本研究は, 科研費(課題番号: JP17K04980 および 23K04518)の補 助を受けた。本研究で実施した放射光実験は,KEK 放 射光実験施設共同利用実験課題(2018G594, 2020G540, 2022G561)で行われた。

引用文献

- R. W. G. Wyckoff, Crystal Structures (R.E. Krieger Publishing Company) (1982).
- [2] R. Groβe, H. Swoboda, and A. Tausend, J. Phys. C: Solid State Phys. 8, L445 (1975).
- [3] Y. H. Zhao and K. Lu, Phys. Rev. B 56, 14330 (1997).
- [4] A. L-Calderon et al., Small 16, 2005447 (2020).
- [5] L. George, V. L. Deringer, A. Wang, P. Müller, U. Englert, and R. Dronskowski, J. Chem. Phys. 145, 234512 (2016).
- [6] D. Koningsberger and R.Prins, X-ray Absorption: Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS, and XANES (Wiley) (1988).
- [7] H. Ikemoto, T. Fujimori, T. Miyanaga, R. Kawaguchi, K. Urita, and M. Tabuchi, J. Phys. Chem. Solids 185, 111737 (2024).
- [8] K. Tamura, et al., J. Phys.: Condens. Matter 3, 7495 (1991).
- [9] M. Inui, M. Yao, and H. Endo, J. Phys. Soc. Jpn. 57, 553 (1988).
- [10] H. Ikemoto, T. Fujimori, T. Miyanaga, S. Kato, F. Iesari, and K. Urita, J. Phys. Chem. C 124, 26043 (2020).
- [11] M. E. Kordesch and R. W. Hoffman, Phys. Rev. B 29, 491 (1984).
- [12] E. Yanase, I. Watanabe, M. Harada, M. Takahashi, Y. Dake, and Y. Hiroshima, Jpn. J. Appl. Phys. 38, 198 (1999).
- [13] H. Ota, T. Akai, H. Namita, S. Yamaguchi, and M. Nomura, J. Power Sources 119–121, 567 (2003).
- [14] H. Ikemoto, T. Miyanaga, M.S. Islam, R. Kawaguchi, J. Phys.: Condensed Matter 36, 325704 (2024).
- [15] C. Nims, B. Cron, M. Wetherington, J. Macalady, and J. Cosmidis, Sci. Rep. 9, 7971 (2019).
- [16] B. Henke, E. Gullikson, and J. Davis, At. Data Nucl. Data Tables 54, 181 (1993).
- [17] H. Ikemoto, J. Synchrotron Radiat. 25, 618 (2018).
- [18] M. Newville, P. Līvinš, Y. Yacoby, J.J. Rehr, and E.A. Stern, Phys. Rev. B 47, 14126 (1993).
- [19] A. L. Ankudinov, B. Ravel, J. J. Rehr, and S. D. Conradson, Phys. Rev. B 58, 7565 (1998).
- [20] B. Ravel and M. Newville, J. Synchrotron Radiat. 12, 537 (2005).
- [21] H. Sakane, T. Miyanaga, I. Watanabe, N. Matsubayashi,S. Ikeda, and Y. Yokoyama, Jpn. J. Appl. Phys. 32, 4641

(1993).

- [22] M. Takemura, H. Satake, S. Yasuami, M. Yoshiki, Y. Kitajima, Spectrochimica Acta B, 54, 159 (1999).
- [23] S. J. Rettig and J. Trotter, Acta Crystallogr. C 43, 2260 (1987).
- [24] D. Scott, J. McCullough, and F. Kruse, J. Mol. Spectrosc. 13, 313 (1964).
- [25] R. Winter, et al, J. Phys.: Condensed Matter 2, 8427 (1990).
- [26] P. Cherin and P. Unger, Inorg. Chem. 6, 1589 (1967).
- [27] C. Adenis, V. Langer, and O. Lindqvist, Acta Crystallogr. C 45, 941 (1989).
- [28] H. Ikemoto and T. Miyanaga, Phys. Rev. Lett. 99, 165503 (2007).

(原稿受付日:2025年3月6日)

著者紹介

池本弘之 Hiroyuki IKEMOTO



富山大学学術研究部理学系 教授 〒 930-8555 富山県富山市五福 3190 e-mail: ikemoto@sci.u-toyama.ac.jp 略歴: 2008 年富山大学理学部教授。 博士(理学)。

最近の研究:XAFS と光電子分光を用いた物性物理。

宮永崇史 Takafumi MIYANAGA



弘前大学理工学部数物科学科 教授
〒 036-8561 青森県弘前市文京町 3
e-mail: takaf@hirosaki-u.ac.jp
略歷:2003 年弘前大学理工学部教授。
理学博士。

最近の研究:XAFS による物性科学,構造のダイナミクス 研究。

趣味:乗馬、水泳、シャンソン。